

様式第五十の二（第48条第6項関係）

認定事業適応計画の（中間）実施状況の概要の公表

1. 認定の日付

令和4年3月2日

2. 認定事業適応事業者の名称

株式会社レゾナック

（令和5年1月1日（以下「移行日」という。）をもって、昭和電工株式会社が持株会社体制に移行することに伴い、昭和電工株式会社は、管理部門を除く全事業を自己の子会社である昭和電工マテリアルズ株式会社へ吸収分割することで承継し、その移行日をもって、昭和電工マテリアルズ株式会社は株式会社レゾナックに商号を変更した。）

3. 認定事業適応計画の実施期間

開始時期：令和4年1月

終了時期：令和6年3月

4. 認定事業適応計画の実施状況

（1）事業適応計画に係る事業の目標の達成状況

現在、パワー半導体の素子の主力はシリコン製ですが、炭化ケイ素(SiC)はシリコンと比較して優れた物性値を持ち、高耐圧・大電流・高温動作・低損失・小型のパワー半導体の素子を実現することができ、省エネ・低消費電力化のキーパーツとして期待されています。

SiC パワー半導体は SiC インゴット成長・基板化→エピタキシャル成長→チップ化→デバイス化→モジュール化→システム化の工程を経て製造されますが、当社では SiC インゴット成長・基板化からエピタキシャル成長までの開発・製造を行っています。

本計画では、SiC インゴット成長・基板化・エピタキシャル成長・工程内及び出荷検査の生産・処理能力を拡充し、省エネ効果の高い SiC パワー半導体の供給を増やすことで、国内の CO2 排出量削減に貢献していくものです。

この計画のうち令和4年度においては、既に SiC インゴット成長・基板化工程の装置のある千葉県市原市の当社工場に、SiC 基板の生産用の新規装置を導入し、生産を開始します。この次工程である、SiC 基板の表面に SiC エピタキシャル成長を施す工程が、埼玉県秩父市の当社工場にあります。本計画で市原市の当社工場に導入した装置で SiC 基板の生産を開始し、その表面に顧客であるデバイスメーカーの要望に沿った仕様でエピタキシャル成長を施し、販売します。

（２）生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを示す目標の達成状況

基準年度から令和４年度までの、SiC エピウェハーの売上高伸び率は 41.4%でした。多くの顧客に弊社製品の品質を認めていただいた結果、当初見込み(34.8%増)を上回る実績となりました。

（３）財務内容の健全性の向上を示す目標の達成状況

株式会社レゾナック（旧、昭和電工株式会社と旧、昭和電工マテリアルズ株式会社の合算値）の財務内容の健全性の向上指標については、令和４年度は有利子負債／CF が 10.3 倍となり、経常収支比率が 116.3%となりました。

（４）実施した事業適応計画の内容

令和４年度は法人税の課税対象とならなかったため、計画したエネルギー利用環境負荷低減事業適応による税制措置は受けていません。

以上